

智慧財產及商業法院行政判決

112年度行專訴字第13號

民國112年9月21日辯論終結

原告 邱雅婷

訴訟代理人 張耀暉專利師（兼送達代收人）

輔佐人 李易儕

訴訟代理人 呂昆餘專利師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 陳俊宏

參加人 美商唯亞威方案公司（VIAVI Solutions Inc.）

代表人 Kevin Siebert 住同上

訴訟代理人 謝祥揚律師（兼送達代收人）

潘皇維律師

李佺穎律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國112年1月31日經訴字第11106310060號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第3項前段規定：本法112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產行政事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定。

二、按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證

據，智慧財產及商業法院仍應審酌之。修正前智慧財產案件審理法第33條第1項定有明文。是當事人於言詞辯論終結前向智慧財產法院提出之新證據，應限於「同一撤銷或廢止理由」，法院始應加以審酌。智慧財產案件審理法第33條第1項規定之目的雖在於減少同一專利權有效性之爭執發生多次爭訟，而容許在行政訴訟中仍得補提新證據，因而放寬專利法有關「舉發證據」提出時點之限制。然該規定仍明文限於「同一撤銷理由」，而所稱「同一撤銷理由」，依其立法目的觀之，應係指同一舉發理由，是以於行政訴訟中仍不得提出新理由，而應受專利法有關「舉發理由」提出時點之限制（最行政法院107年度判字第36號判決意旨參照）。查本件原告於提起舉發時係主張證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合足以證明發明第I648561號專利（下稱系爭專利）請求項27違反核准時專利法第22條第2項而不具進步性（見原處分乙證1卷第110頁），其後於行政訴訟階段始提出「系爭專利請求項27違反專利法第26條第4項暨專利法施行細則第18條第2項之規定」之主張，顯非基於同一撤銷理由，不符合智慧財產案件審理法第33條第1項規定，不應准許。

貳、實體事項：

一、事實概要：

參加人前於102年7月15日以「光學濾波器及感測器系統」向被告申請發明專利，並聲明以西元2012年7月16日申請之美國第61/672,164號專利案主張優先權，經編為第102125288號審查。嗣參加人於106年1月20日申請分割出第106102014號「光學濾波器及感測器系統」發明專利申請案，並經被告審查後，准予專利，發給發明第I648561號專利證書（即系爭專利，申請專利範圍共27項）。其後，原告以系爭專利違反核准時（即106年1月18日修正公布、同年5月1日施行）專利法第22條第1項、第2項、第26條第2項、第4項等規定，對之提起舉發。案經被告審查，以111年8月18日（111）智專

01 三（二）04457字第11120817520號專利舉發審定書為「請求
02 項1至26舉發成立，應予撤銷」及「請求項27舉發不成立」
03 之處分。原告不服前揭舉發不成立部分之處分，提起訴願，
04 復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起
05 本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及
06 原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損
07 害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

08 二、原告聲明請求判決被告關於「請求項27舉發不成立」部分及
09 訴願決定均撤銷；被告對於原告110年3月11日申請之系爭專
10 利舉發案，應作成「請求項27舉發成立」之處分或作成適法
11 之處分，並主張：

12 在被告已經判定證據2已經公開系爭專利請求項27所界定的
13 光學濾波器的技術內容的情況下，相關技術人員將證據2所
14 公開的光學濾波器，利用光譜儀進行測試並通過簡單的計
15 算，當然也會得到與系爭專利請求項27所界定「中心波長在
16 一入射角自 0° 至 30° 間之一改變之情況下在量值上移位小於1
17 3nm」完全相同的「測試結果」；是以，系爭專利所屬技術
18 領域中具有通常知識者，參酌證據2及公知常識，可輕易完
19 成系爭專利請求項27，系爭專利請求項27對比於證據2，當
20 然不具進步性。退步言之，若是系爭專利權人稱利用「光譜
21 儀」對證據2所公開的光學濾波器進行測試，無法達到系爭
22 專利請求項27所界定「中心波長在一入射角自 0° 至 30° 間之
23 一改變之情況下在量值上移位小於13nm」之「測試結果」，
24 則代表系爭專利請求項27缺乏記載「光學濾波器」所包含的
25 「有別於證據2所公開的技術特徵」。

26 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

27 （一）原告自承證據2、證據2、4之結合、證據2、4、5之結合或證
28 據2、6之結合，該些證據結合之差異在「該中心波長在一入
29 射角自 0° 至 30° 間之一改變之情況下在量值上移位小於13n
30 m」技術特徵，系爭專利請求項27依附於請求項25之附屬
31 項，包含請求項25所有技術特徵，證據2、4、5、6未揭示系

01 爭專利請求項25上開之技術特徵，前開證據亦不足以證明包
02 含請求項25全部技術特徵之請求項27不具進步性，是以，證
03 據2，或證據2、4之結合，或證據2、4、5之結合，或證據
04 2、6之結合不足以證明系爭專利請求項27不具進步性。

05 (二)附件1、附件2僅能說明光譜儀對光學濾波器進行量測，且附
06 件1之高折射率材料為TiO₂，其光學濾波器之通帶中心波長
07 在380nm~680nm間、光入射角30°改變下量值移位約20nm，附
08 件1之高折射率材料TiO₂為系爭專利習用光學濾波器之材料
09 ，亦為系爭專利所欲用氮化矽替換之材料，附件1之TiO₂材
10 料形成之移位約20nm，無法證明包含依附請求項25之請求項
11 27之「該中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況
12 下在量值上移位小於13nm」、「氮化矽層」技術特徵。

13 (三)又置入光譜儀之光學濾波器如果是系爭專利產品或侵權物，
14 當然得到系爭專利請求項27之相同測試結果，惟原告未證明
15 置入光譜儀之光學濾波器是系爭專利申請前已經存在之產
16 品，更沒有提供光譜儀量測結果以資佐證包含依附請求項25
17 之請求項27之「該中心波長在一入射角自0°至30°間之一改
18 變之情況下在量值上移位小於13nm」、「氮化矽層」技術特
19 徵。另原告沒有提供證據證明證據2之濾波器置入光譜儀進
20 行測試結果，相同的「測試結果」僅為原告之臆測。

21 四、參加入聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：

22 (一)證據2未揭示請求項27「中心波長在入射角自0°至30°間位移
23 小於13nm」之技術特徵，甚且未見有任何有關「中心波長位
24 移」之描述。況且，當考慮到PECVD技術所導致的厚度變化
25 時，所產生的濾光片未必會表現出「中心波長在入射角自0°
26 至30°間之一改變之情況下在量值上位移小於13nm」之特
27 徵。亦即，並非所有模擬（或實際製造）都必然會導致濾光
28 片的「中心波長在入射角自0°至30°間之一改變之情況下在
29 量值上位移小於13nm」，證據2未揭示「中心波長在入射角
30 自0°至30°間移位小於13nm」之技術特徵。又證據4、5、6均
31 未記載請求項27技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位

之「特定數值與範圍」，且原告所謂「提高高折射率層材料之折射率可使光學濾波器通帶之中心波長隨入射角變化時的移位幅度減少」、「加大高折射率層之光學膜厚與低折射率層之光學膜厚之比，以減少中心波長偏移幅度」云云，僅係定性描述，並非定量描述。從而，證據4、5、6未揭露請求項27上開技術特徵。發明所屬技術領域具有通常知識者，自無從基於證據4、5、6得知請求項27上開技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位之「特定數值與範圍」。綜上，證據2、4、5、6均未揭露系爭專利請求項27「中心波長在入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上位移小於13nm」之技術特徵，無法證明系爭專利請求項27不具進步性。

五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並協議簡化爭點如下：

(一)不爭執事項：

如事實及理由欄貳、一、事實概要所示。

(二)本件爭點：

證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組合，是否足以證明系爭專利請求項27不具進步性？

六、得心證之理由：

(一)查被告於107年11月13日審定核准系爭專利，故系爭專利是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之106年1月18日修正公布，同年5月1日施行之專利法規定為斷，合先敘明。

(二)系爭專利技術分析：

1.在一典型示意動作辨識系統中，一光源朝向一使用者發射近紅外線光。一個三維(3D)影像感測器偵測由該使用者反射之所發射光以提供該使用者之一3D影像。接著，一處理系統分析該3D影像以辨識由該使用者做出之一示意動作。一光學濾波器(更具體而言，一帶通濾波器)用以將所發射光透射至3D影像感測器，同時實質上阻擋周圍光。換言之，光學濾波器

01 用於篩選出周圍光。因此，需要具有在近紅外線波長範圍(
02 亦即，800 nm至1100nm)中之一窄通帶之一光學濾波器。參
03 考圖1至圖3，第一、第二及第三習用光學濾波器通常具有在
04 通帶內之一高透射率位準及在通帶外側之一高阻擋位準。然
05 而，通帶之中心波長隨著入射角之改變經受一相對大移位。
06 因此，通帶必須相對寬以接受在所需入射角範圍內之光，從
07 而增加經透射之周圍光之量且減小併入有此等習用光學濾波
08 器之系統之信雜比。此外，濾波器堆疊及阻擋堆疊中之大數
09 目之層增加製作此等習用光學濾波器中所涉及之費用及塗佈
10 時間。大總塗層厚度亦使得難以(例如)藉由光微影來圖案化
11 此等習用光學濾波器。為增強示意動作辨識系統中之光學濾
12 波器之效能，將期望減少層之數目、總塗層厚度及隨著入射
13 角改變之中心波長移位。一種方法係針對高折射率層使用在
14 800nm至1100nm之波長範圍內具有比習用氧化物高之一折射
15 率之一材料。除一較高折射率以外，材料亦必須在800nm至1
16 100nm之波長範圍內具有一低消光係數以便在通帶內提供一
17 高透射率位準。Lairson等人在標題為「Reduced Angle-Shi
18 ft Infrared Bandpass Filter Coatings」之一文章(SPIE
19 之會議記錄，2007年，6545卷，65451C-1至65451C-5頁)中
20 及Gibbons等人在標題為「Development and Implementatio
21 n of a Hydrogenated a-Si Reactive Sputter Deposition
22 Process」之一文章(真空塗佈機協會之年度技術會議之會議
23 記錄，2007年，50卷，327至330頁)中皆揭示了在光學濾波
24 器中將氫化矽(Si:H)用於高折射率層。Lairson等人揭示了
25 在1500nm之一波長下具有3.2之一折射率且在大於1000nm之
26 波長下具有小於0.001之一消光係數之一氫化矽材料。Gibbo
27 ns等人揭示了藉由交流電(AC)濺鍍生產之在830nm之一波長
28 下具有3.2之一折射率且在830nm之一波長下具有0.0005之一
29 消光係數之一氫化矽材料。遺憾地，此等氫化矽材料在800
30 nm至1100nm之波長範圍內並不具有一合適低消光係數(摘自
31 系爭專利說明書第1頁[先前技術]第1、2、5、6、7段)。

01 2.系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示。

02 3.申請專利範圍分析：

03 系爭專利核准公告時申請專利範圍之請求項總計27 項，與
04 本件相關者為請求項27，因該項為請求項25獨立項之附屬項
05 是請求項25、27內容如下：

06 請求項25：一種光學濾波器，其包含：複數個層，其中該複
07 數個層包括若干氮化矽層及若干較低折射率層，
08 其中該等氮化矽層中之至少一者比該等較低折射
09 率層中之至少一者更厚，且其中該光學濾波器具
10 有一通帶且該通帶具有一中心波長，且該中心波
11 長在一入射角自 0° 至 30° 間之一改變之情況下在
12 量值上移位小於13nm。

13 請求項27:如請求項25之光學濾波器，其中該等氮化矽層之
14 一折射率大於3。

15 (三)舉發證據技術分析：

16 1.證據2係1995年3月14日公告之美國第5,398,133號「HIGH E
17 NDURANGE NEAR-INFRARED OPTICAL WINDOW」專利案，其公
18 告日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)可為系爭專
19 利相關之先前技術。證據2第5欄第28至60行揭露「除了近
20 紅外光流線式濾光器外，還可以使用疊加原理實現其他類
21 型的光學濾光器。當圖4中所示的近紅外光流線式濾光器的
22 基板背面用低通濾光器28塗佈時，得到窄帶通濾光器。窄
23 帶通的位置係藉由近紅外光高通濾光器26和低通濾光器28
24 的層的數量和厚度而確定。圖10顯示基於本發明的窄帶通
25 濾光器的結構的截面圖。近紅外光高通濾光器有14層，低
26 通濾光器28有13層。表3描述了13層低通濾光器的結構參數
27 其中a-SiNx:H作為離基板最遠的最後一層圖11顯示基於
28 本發明的低通濾光器28的透射率。在800-980nm波長範圍內
29 透射率超過95%並且與圖5中所示的近紅外光流線式濾光
30 器的透射帶重疊。在1040-1500nm波長範圍內，透射率幾乎
31 等於零。因此，一部分近紅外光被阻擋。圖12顯示基於本

發明的窄帶通濾光器的透射率。800-1000nm範圍內的透射率峰值為99.23%，帶寬為185nm，具有近似矩形的形狀」，證據2主要圖式如本判決附圖二所示。

- 2.證據4為2001年1月26日出版之「H Angus Macleod THIN-FILM OPTICAL FILTERS Third Edition」教科書第283至292頁，其公開日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)，可為系爭專利相關之先前技術。如果在空氣中的入射角為

θ_i ， $\theta = \sin^{-1}(\sin \theta_i / n^*)$ ，以及 Δg 以 θ_i 和 n^* 之形式求出。傾斜之效應，接著，此理想的濾光片可以從入射角與隔離層折射率的知識中被簡單的估計出來。對於小入射角，可得到相移為：

$$\Delta g = \Delta v / v_0 = \Delta \lambda / \lambda_0 = \theta_i^2 / 2n^{*2}. \quad (7.28)$$

這裡隔離層折射率 n^* 決定它如何靈活的傾斜：較高的折射率影響濾光片較少。對於真實的濾光片而言，反射器也受到傾斜的影響，因此計算峰值波長的變化就更投入。然而，Pidgeon和Smith表明，這種相移類似於從具有隔離層折射率 n^* 的理想濾光片中所得，濾光片層的高折射率和低折射率之間的中間的 n^* 稱為有效折射率。有效折射率的概念適用於相當高的入射角度，高達20度或30度，甚至更高，具體取決於組成濾光片的多層的折射率(證據4第284頁第1至15行)。對於第一階濾光片

$$n^* = (n_H n_L)^{1/2} \quad (7.34)$$

這是Pidgeon和Smith獲得的結果。當 $m \rightarrow \infty$ ，則 $n^* \rightarrow n_H$ ，如同我們所預期(證據4第286頁第5至8行)。證據4主要圖式如本判決附圖三所示。

- 3.證據5為2007年5月4日公開之「Reduced angle-shift infrared bandpass filter coatings」技術文獻，其公開日期早於系爭專利優先權日(2012年7月16日)，可為系爭專利相關之先前技術。在整個堆疊設計中使用高折射率材料可以大大提高給定塗層厚度下的性能，或者大大降低實現設計

01 所需的總厚度。證據5討論了通過多層氮化矽實現的幾種設
02 計，這些設計展示了在傾斜入射角下的改進性能(參證據5
03 摘要)。

04 4.證據6為2009年3月18日公開之中國第CN101389982A號「分
05 色鏡」專利案，其公開日期早於系爭專利優先權日(2012年
06 7月16日)，可為系爭專利相關之先前技術。證據6提供一種
07 即使雜散光的入射角變大，亦能使雜散光難以透射的分色
08 鏡。玻璃等透明基板(1)的一面形成有第1多層膜濾波器
09 (2)，在另一面形成有第2多層膜濾波器(3)。將多層膜濾波
10 器(2)作為低通濾波器，將多層膜濾波器(3)作為高通濾波
11 器。並將多層膜設計成因入射角的變化導致的分光透射特
12 性的偏移，在多層膜濾波器(3)大於在多層膜濾波器(2)。
13 從而，即使多層膜濾波器(2)產生因分光透射特性的偏移
14 而應被遮光的波長透射的情形，亦能借助多層膜濾波器(3)
15 的分光透射特性的偏移來遮斷該波長的透射。因此，可大
16 幅降低以較大入射角入射的雜散光透射過分色鏡的比率。

17 (四)證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6
18 之組合，不足以證明系爭專利請求項27不具進步性：

19 1.系爭專利請求項27為依附於請求項25之附屬項，包含請求
20 項27之所有技術特徵，並進一步界定「其中該等氮化矽層
21 之一折射率大於3」。將系爭專利請求項27與證據2或證據
22 2、4之組合或證據2、4、5之組合或證據2、6之組相比對可
23 知：

24 (1)證據2說明書第1欄第60至30行揭露「…窄帶通濾光
25 器…」；證據2說明書第4欄第3至6行揭露「…a-Si:H
26 (即氮化矽層)/ a-SiN_x:H…」；證據2圖4揭露「a-Si:
27 H(即氮化矽層)/ a-SiN_x:H交互堆疊」：證據2表1揭露
28 層26-2及26-4「a-SiN_x:H」的折射率為1.82，層26-3
29 「a-Si:H(即氮化矽層)」折射率為3.62，層26-6「a-S
30 iN_x:H」厚度為42.10nm，層26-7「a-Si:H」厚度為85.26
31 nm；證據2圖12及說明書第6欄第1至5行揭露一種窄帶通

濾波器，在800~1000nm範圍透射率99.23%，帶寬185nm等內容。

(2)由上述內容可知，證據2揭示一種使用複數a-Si:H(氫化矽層)/ a-SiNx:H交互堆疊實現窄帶通濾光器，該「a-SiNx:H」折射率小於「a-Si:H(即氫化矽層)」，該「a-Si:H(即氫化矽層)」的厚度比該複數個「a-SiNx:H」之至少一者更厚，其中該窄帶通濾波器，在800~1000nm範圍內具有帶寬185nm。其中，證據2「窄帶通濾光器」相當於系爭專利請求項27之「光學濾波器」；證據2「a-Si:H(即氫化矽層)」相當於系爭專利請求項27之「若干氫化矽層」；證據2「a-SiNx:H」相當於系爭專利請求項27之「若干較低折射率層」；證據2【該「a-Si:H(即氫化矽層)」的厚度比該複數個「a-SiNx:H」之至少一者更厚】相當於系爭專利請求項27之「該等氫化矽層中之至少一者比該等較低折射率層中之至少一者更厚」；證據2「在800~1000nm範圍內具有帶寬185nm」相當於系爭專利請求項27之「具有與800nm至1100nm之一波長範圍至少部分重疊之一通帶(passband)」；證據2表1【層26-3「a-Si:H(即氫化矽層)」折射率為3.62】相當於系爭專利請求項27之「其中該等氫化矽層之一折射率大於3」，故證據2已揭示系爭專利請求項27依附請求項25「一種光學濾波器，其包含：複數個層，其中該複數個層包括若干氫化矽層及若干較低折射率層，其中該等氫化矽層中之至少一者比該等較低折射率層中之至少一者更厚，且其中該光學濾波器具有一通帶且該通帶具有一中心波長」與「其中該等氫化矽層之一折射率大於3」技術特徵。

(3)依上述比對，系爭專利請求項27與證據2之差異在於：證據2未揭示系爭專利請求項27「且該中心波長在一入射角自0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」之技術特徵。舉發理由書第54頁第6行雖主張「上述差異

技術特徵為功效技術特徵，由結構特徵所產生功效技術特徵，可為所屬技術領域具有通常知識者輕易完成」云云。惟查，上開技術特徵為「必要技術特徵」已如前述，且系爭專利說明書均未主張「上述差異技術特徵」為原告所稱「功效技術特徵」情況下，原告主張不足採。

(4)證據4未教示或建議如何取捨折射率的情況下，證據5揭示在特定入射角 48° 至 42° 間具有中心波長為17nm之偏移幅度，但並未揭露在「入射角」為 41° 至 0° 時，是否仍一直保持在「具有中心波長為17nm之偏移幅度」，證據6僅為定性教示光學膜厚之比值與中心波長的移位幅度之關係，故證據2、4、5、6均未揭示系爭專利請求項27「上述差異技術特徵」。綜上所述，證據2；證據2、4之組合；證據2、4、5之組合；證據2、6之組合不足以證明系爭專利請求項27不具進步性。

2.原告舉發理由書雖稱：「由證據4、5可知提高折射率層材料之折射率可使光學濾波器通帶之中心波長隨入射角變化時的移位幅度減少，故而此一技術特徵為所屬技術領域具有通常知識者，可運用被舉發案申請時之通常知識輕易完成」、「證據6亦揭露可利用加大高折射率層之光學膜厚與低折射率層的光學膜厚之比，以減少中心波長偏移幅度，給予如何減少中心波長偏移幅度之教示…使中心波長在光入射角自 0° 改變至 30° 時，移位幅度維持在13(nm)以內」云云（參見乙證1卷第113頁，專利舉發理由書第53至54頁表格內容）。然查，證據4、5、6均未記載請求項27上開技術特徵所界定入射角變化與中心波長移位之『特定數值與範圍』，且原告所謂「提高折射率層材料之折射率可使光學濾波器通帶之中心波長隨入射角變化時的移位幅度減少」、「加大-折射率層之光學膜厚與低折射率層的光學膜厚之比，以減少中心波長偏移幅度」云云，僅係定性描述，並非定量描述。從而，證據4、5、6未揭露請求項27上開技術特徵。發明所屬技術領域具有通常知識者，自無從

01 基於證據4、5、6得知請求項27上開技術特徵所界定入射角
02 變化與中心波長移位之「特定數值與範圍」，是以原告此
03 部分主張不可採。

04 3.原告行政訴訟起訴狀主張依附件1：2009年4月29日公開中
05 國第CN101421641A號專利（本院卷一第93至138頁）及附件
06 2：台灣安捷倫科技股份有限公司」於2011年5月1日所印刷
07 公開的「CARY 4000/5000/6000I系列紫外-可見-近紅外分
08 光光度計」型錄（本院卷一第139至154頁）可證明「利用
09 『光譜儀』對『光學濾波器』進行測試，以取得該光學濾
10 波器於特定入射角所對應的中心波長」為本領域的公知常
11 識，將證據2依上述相同於附件1及2的證據方法，當然也會
12 得到與系爭專利請求項27所界定「中心波長在一入射角自
13 0°至30°間之一改變之情況下在量值上移位小於13nm」完全
14 相同的「測試結果」，又參行政訴訟起訴狀第10頁以附件2
15 之紫外-可見-近紅外分光光度計(光譜儀)配合調整Brewste
16 r角支架設定入射角度，可得到中心波長從851.5nm位移至8
17 38.5nm的波長-穿透率圖云云(本院卷一第87、90頁)。惟
18 查，原告未舉證以附件2紫外-可見-近紅外分光光度計（光
19 譜儀）配合調整Brewster角支架對「待測品，即光學濾波
20 器」是否為證據2所實施產品，抑或早於系爭專利優先權日
21 之前，顯然無法將該「待測品，即光學濾波器」視為與證
22 據2所實施產品相同，故原告所述不足採。

23 七、綜上所述，證據2或證據2、4之組合或證據2、4、5之組合或
24 證據2、6之組合，不足以證明系爭專利請求項27不具進步性
25 ，從而，被告所為系爭專利請求項27舉發不成立之原處分，
26 符合法律規定，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前
27 詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並作成「請求項27舉發成
28 立」之處分，為無理由，應予駁回。

29 八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資
30 料經本院斟酌後，認與判決結果沒有影響，無逐一論述的必
31 要。

九、結論：本件原告之訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中華民國 112 年 10 月 12 日

智慧財產第二庭

審判長法官 彭洪英

法官 汪漢卿

法官 曾啓謀

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。

01

(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人

1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。
2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。
3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。

是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。

02

中 華 民 國 112 年 10 月 23 日

03

書記官 丘若瑤